

LPV811/LPV812 425nA 精密毫微功耗运算放大器

1 特性

- 毫微功耗电源电流：425nA/通道
- 偏移电压：300 μ V（最大值）
- $T_C V_{OS}$ ：1 μ V/ $^{\circ}$ C
- 增益带宽：8kHz
- 单位增益稳定
- 低输入偏置电流：100fA
- 宽电源电压范围：1.6V 至 5.5V
- 轨到轨输出
- 无输出反转
- EMI 保护
- 温度范围：-40 $^{\circ}$ C 至 125 $^{\circ}$ C
- 行业标准封装：
 - 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装（单通道版本）
 - 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装（双通道版本）

2 应用

- CO 和 O₂ 气体探测器 (TIDA-0756)
- PIR 运动检测器
- 电流感测
- 温度调节装置
- 物联网 (IoT) 远程传感器
- 有效的射频识别 (RFID) 阅读器和标签
- 便携式医疗设备

3 说明

LPV811（单通道）和 LPV812（双通道）系列超低功耗精密运算放大器是由电池供电的无线设备和低功耗有线设备中“常开”感测 中的感测应用。凭借 8kHz 带宽、425nA 静态电流以及削减至 300 μ V 以下的偏移电压，LPV81x 放大器具备所需的高精度特性，同时能够为注重电池寿命的设备（例如气体检测器和便携式电子设备）将功耗降至最低。

除超低功耗特性外，LPV81x 放大器还具有实现毫微微安偏置电流的 CMOS 输入级，可用于阻抗源 应用。

LPV81x 放大器还特有一个负轨感测输入级和一个相对于电源轨的摆幅为毫伏级的轨到轨输出级，从而尽可能保持最宽的动态范围。LPV81x 设有电磁干扰 (EMI) 保护，可降低来自手机、WiFi、无线电发射器和标签阅读器的无用射频信号对系统造成的影响。

Device Information⁽¹⁾

PART NUMBER	PACKAGE	封装尺寸
LPV811	SOT-23 (5)	2.90mm x 1.60mm
LPV812	VSSOP (8)	3.00mm x 3.00mm

LPV8xx 系列毫微功耗放大器

器件编号	通道	电源电流 (典型值/通道)	偏移电压 (最大值)
LPV801	1	500nA	3.5mV
LPV802	2	320nA	3.5mV
LPV811	1	450nA	370 μ V
LPV812	2	425nA	300 μ V

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

图 1. 毫微功耗 CO 传感器

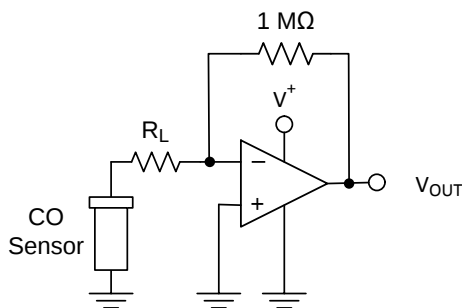
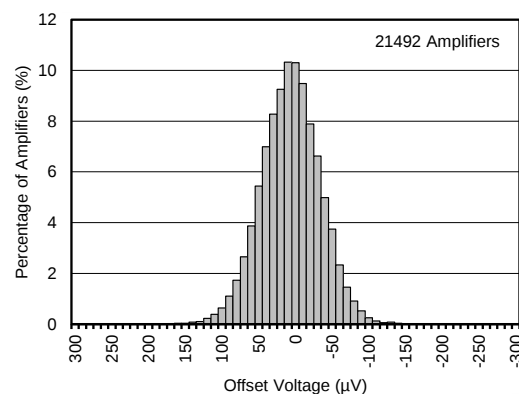


图 2. LPV812 偏移电压分布



目录

1	特性	1	8	应用和实现	15
2	应用	1	8.1	应用信息	15
3	说明	1	8.2	典型应用: 三端 CO 气体传感器放大器	15
4	修订历史记录	2	8.3	注意事项	18
5	引脚配置和功能	3	9	电源建议	18
6	规格	4	10	布局	18
6.1	绝对最大额定值	4	10.1	布局指南	18
6.2	ESD 额定值	4	10.2	布局示例	18
6.3	建议的工作条件	4	11	器件和文档支持	19
6.4	热性能信息	4	11.1	器件支持	19
6.5	电气特性	4	11.2	Documentation Support	19
6.6	典型特性	6	11.3	相关链接	19
7	详细 说明	13	11.4	Receiving Notification of Documentation Updates	19
7.1	概述	13	11.5	Community Resources	19
7.2	功能框图	13	11.6	商标	19
7.3	特性 说明	13	11.7	静电放电警告	20
7.4	器件功能模式	13	11.8	Glossary	20
			12	机械、封装和可订购信息	20

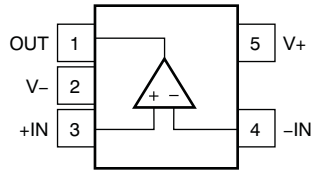
4 修订历史记录

Changes from Revision A (October 2016) to Revision B	Page
• 已添加 系列向上销售表至首页	1
• 已更改 首页的 O2 感测电路至 Vos 分布图	1
• 已删除 更大的向上销售表	2
• 已删除 删除了 LPV811 预览“初步规格”表注。	4
• 已添加 添加了单独的 LPV811 CMRR 规格。	5
• 已添加 失调电压分布图	6

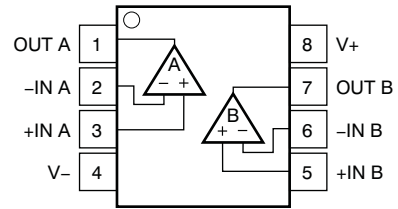
Changes from Original (August 2016) to Revision A	Page
• 已更改 “产品预览”至“量产数据”。	1

5 引脚配置和功能

**LPV811 5 引脚 SOT-23
DBV 封装
俯视图**



**LPV812 8 引脚 VSSOP
DGK 封装
俯视图**



引脚功能: LPV811 DBV

引脚		类型	说明
名称	编号		
OUT	1	O	输出
-IN	4	I	反相输入
+IN	3	I	同相输入
V-	2	P	负电源 (最低)
V+	5	P	正电源 (最高)

引脚功能: LPV812 DGK

引脚		类型	说明
名称	编号		
OUT A	1	O	通道 A 输出
-IN A	2	I	通道 A 反相输入
+IN A	3	I	通道 A 同相输入
V-	4	P	负电源 (最低)
+IN B	5	I	通道 B 同相输入
-IN B	6	I	通道 B 反相输入
OUT B	7	O	通道 B 输出
V+	8	P	正电源 (最高)

6 规格

6.1 绝对最大额定值

在自然通风温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

			最小值	最大值	单位
电源电压，V _s = (V+) - (V-)			-0.3	6	V
输入引脚	电压 ⁽²⁾ ⁽³⁾	共模	(V-) - 0.3	(V+) + 0.3	V
		差模	(V-) - 0.3	(V+) + 0.3	V
输入引脚	电流		-10	10	mA
输出短路电流 (A) (4)			持续	持续	
贮存温度，T _{stg}			-65	150	°C
结温				150	°C

- (1) 超出绝对最大额定值下列值的应力可能会对器件造成永久损坏。这些仅为在极端额定值下的工作情况，这不表示在这些条件下以及其它在超出推荐的操作条件下的任何其它操作时，器件能够功能性操作。在绝对最大额定值条件下长时间运行会影响器件可靠性。
- (2) 以 V- 为基准，在 ANY 引脚上不超过 -0.3V 或 +6.0V
- (3) 输入端子被二极管钳制至电源轨。对于摆幅超过电源轨 0.3V 的输入信号，必须将其电流限制为 10mA 或者更低。
- (4) 对 $V_S/2$ 短路，每个封装对应一个放大器。在高环境温度下持续短路运行可能会导致超过允许的最大结温 (150°C)。

6.2 ESD 额定值

		值	单位
$V_{(ESD)}$ 静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ⁽¹⁾	±1000	V
	充电器件模型 (CDM)，符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 ⁽²⁾	±250	

- (1) JEDEC 文档 JEP155 规定：500V HBM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。如果具备必要的预防措施，则可以在低于 500V HBM 时进行生产。列为 ±2000V 的引脚实际上可能具有更高的性能。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 规定：250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。如果具备必要的预防措施，则可以在低于 250V CDM 时进行生产。列为 ±750V 的引脚实际上可能具有更高的性能。

6.3 建议的工作条件

在自然通风温度范围内测得（除非另有说明）

	最小值	最大值	单位
电源电压 (V+ - V-)	1.6	5.5	V
额定温度范围	-40	125	°C

6.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		LPV811 DBV (SOT-23) 5 引脚	LPV812 DGK (VSSOP) 8 引脚	单位
θ_{JA}	结至环境热阻	177.4	177.6	°C/W
θ_{JCTop}	管结到散热片（顶部）热阻	133.9	68.8	
θ_{JB}	结至电路板热阻	36.3	98.2	
Ψ_{JT}	结至顶部的特征参数	23.6	12.3	
Ψ_{JB}	结至电路板的特征参数	35.7	96.7	

- (1) 有关传统和新热指标的更多信息，请参阅《半导体和 IC 封装热指标》应用报告，SPRA953。

6.5 电气特性

除非另有说明，否则 $T_A = 25^\circ\text{C}$ ， $V_S = 1.8\text{V}$ 至 5V ， $V_{CM} = V_{OUT} = V_S/2$ ， $R_L \geq 10\text{M}\Omega$ （连接至 $V_S/2$ ）。

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
失调电压							
V _{OS}	输入失调电压, LPV811	V _S = 1.8V 和 3.3V, V _{CM} = V-			±60	±370	μV
	输入失调电压, LPV812	V _S = 1.8V 和 3.3V, V _{CM} = V-			±55	±300	μV
ΔV _{OS} /ΔT	输入偏移漂移	V _{CM} = V-	T _A = -40°C 至 125°C		±1		μV/°C

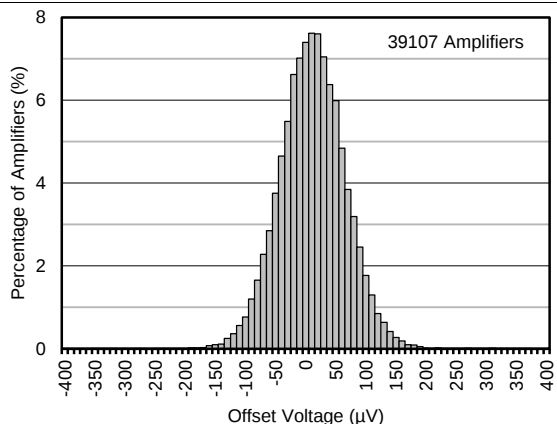
电气特性 (接下页)

除非另有说明, 否则 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = 1.8\text{V}$ 至 5V , $V_{CM} = V_{OUT} = V_S/2$, $R_L \geq 10\text{M}\Omega$ (连接至 $V_S/2$)。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
PSRR	电源抑制比	$V_S = 1.8V$ 至 $3.3V$, $V_{CM} = V^-$	± 1.6		± 60	$\mu V/V$
输入电压范围						
V_{CM}	共模电压范围	$V_S = 3.3V$	0		2.4	V
CMRR	共模抑制比, LPV811	$(V^-) \leq V_{CM} \leq (V^+) - 0.9V$, $V_S = 3.3V$	77	95		dB
	共模抑制比, LPV812	$(V^-) \leq V_{CM} \leq (V^+) - 0.9V$, $V_S = 3.3V$	80	98		dB
输入偏置电流						
I_B	输入偏置电流	$V_S = 1.8V$	± 100			fA
I_{OS}	输入失调电流	$V_S = 1.8V$	± 100			fA
输入阻抗						
	差模		7			pF
	共模		3			pF
噪声						
E_n	输入电压噪声	$f = 0.1Hz$ 至 $10Hz$	6.5			$\mu Vp-p$
e_n	输入电压噪声密度	$f = 100Hz$	340		$nV/\sqrt{Hz}$	
		$f = 1kHz$	420			
开环增益						
A_{OL}	开环电压增益	$(V^-) + 0.3V \leq V_O \leq (V^+) - 0.3V$, $R_L = 100k\Omega$	120			dB
输出						
V_{OH}	相对于正电源轨的电压输出摆幅	$V_S = 1.8V$, $R_L = 100k\Omega$ (连接至 $V^+/2$)	10	3.5		mV
V_{OL}	相对于负电源轨的电压输出摆幅	$V_S = 1.8V$, $R_L = 100k\Omega$ (连接至 $V^+/2$)		2.5	10	
I_{SC}	短路电流	$V_S = 3.3V$, 对 $V_S/2$ 短路	4.7			mA
Z_O	开环输出阻抗	$f = 1KHz$, $I_O = 0A$	90			k Ω
频率响应						
GBP	增益带宽积	$C_L = 20pF$, $R_L = 10M\Omega$, $V_S = 5V$	8			kHz
SR	压摆率 (10% 至 90%)	$G = 1$, 上升沿, $C_L = 20pF$, $V_S = 5V$	2		V/ms	
		$G = 1$, 下降沿, $C_L = 20pF$, $V_S = 5V$	2.1			
电 源						
I_Q	静态电流, LPV811	$V_{CM} = V^-$, $I_O = 0$, $V_S = 3.3V$	450	540	nA	
	静态电流, 每通道, LPV812	$V_{CM} = V^-$, $I_O = 0$, $V_S = 3.3V$	425	495		

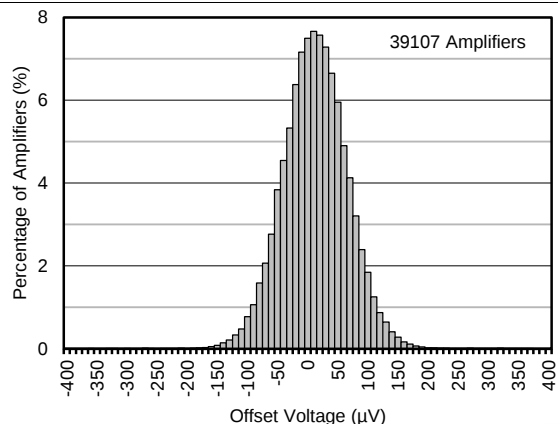
6.6 典型特性

除非另有说明，否则 $T_A = 25^\circ\text{C}$ ， $R_L = 10\text{M}\Omega$ （连接至 $V_S/2$ ）， $C_L = 20\text{pF}$ ， $V_{CM} = V_S/2V$ 。



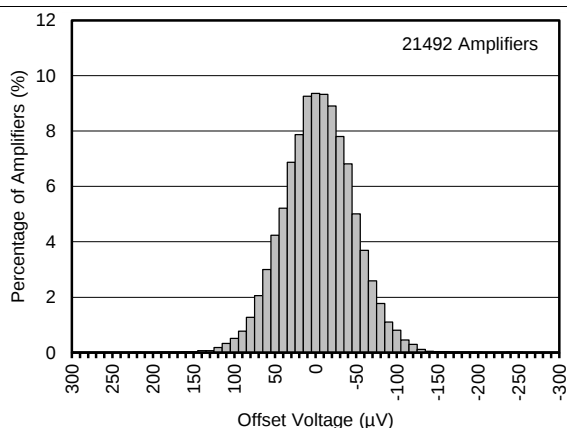
$V_S = 1.8\text{V}$ LPV811
 $T_A = 25^\circ\text{C}$ $V_{CM} = V_-$ $R_L = \text{空载}$

图 3. LPV811 的失调电压分布



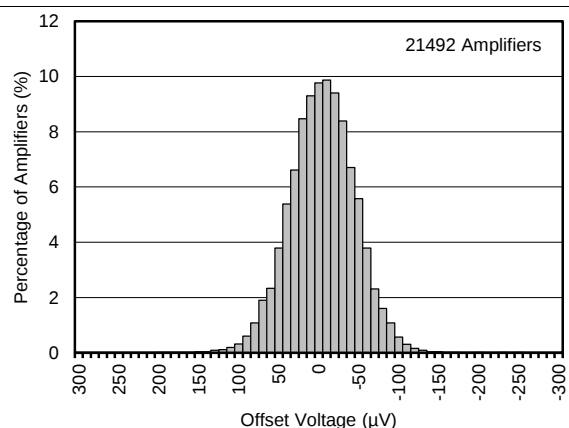
$V_S = 3.3\text{V}$ LPV811
 $T_A = 25^\circ\text{C}$ $V_{CM} = V_-$ $R_L = \text{空载}$

图 4. LPV811 的失调电压分布



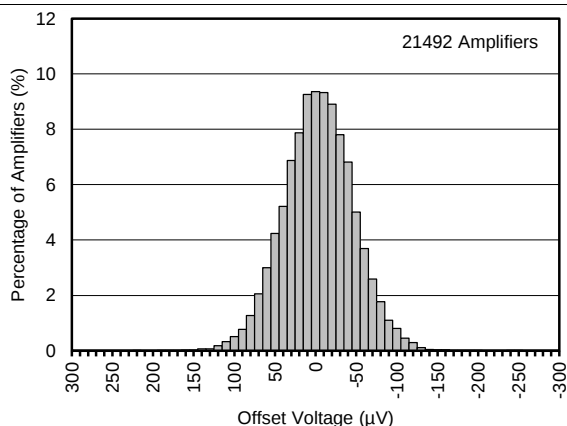
$V_S = 1.8\text{V}$ LPV812, 通道 A
 $T_A = 25^\circ\text{C}$ $V_{CM} = V_-$ $R_L = \text{空载}$

图 5. LPV812 的失调电压分布, 通道 A



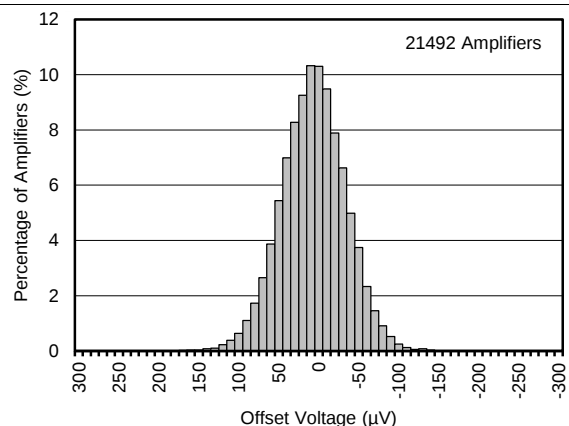
$V_S = 3.3\text{V}$ LPV812, 通道 A
 $T_A = 25^\circ\text{C}$ $V_{CM} = V_-$ $R_L = \text{空载}$

图 6. LPV812 的失调电压分布, 通道 A



$V_S = 1.8\text{V}$ LPV812, 通道 B
 $T_A = 25^\circ\text{C}$ $V_{CM} = V_-$ $R_L = \text{空载}$

图 7. LPV812 的失调电压分布, 通道 B



$V_S = 3.3\text{V}$ LPV812, 通道 B
 $T_A = 25^\circ\text{C}$ $V_{CM} = V_-$ $R_L = \text{空载}$

图 8. LPV812 的失调电压分布, 通道 B

典型特性 (接下页)

除非另有说明, 否则 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $R_L = 10\text{M}\Omega$ (连接至 $V_S/2$), $C_L = 20\text{pF}$, $V_{CM} = V_S/2$ 。

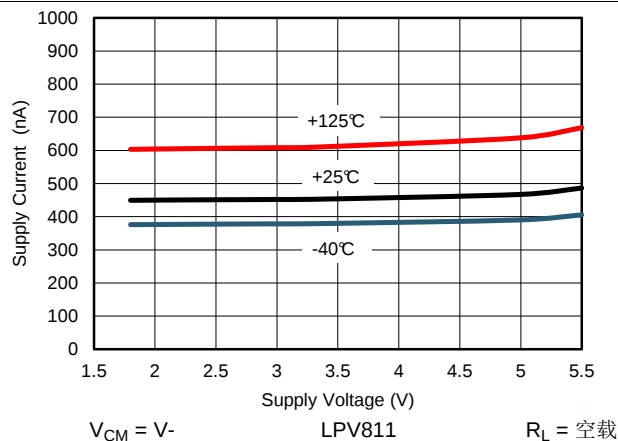


图 9. 电源电流与电源电压间的关系, LPV811

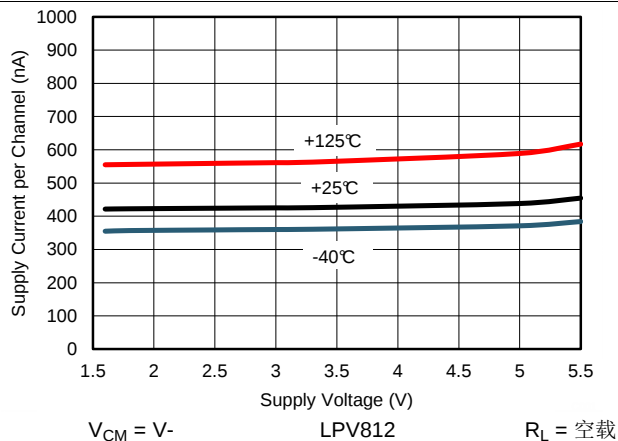


图 10. 电源电流与电源电压间的关系, LPV812

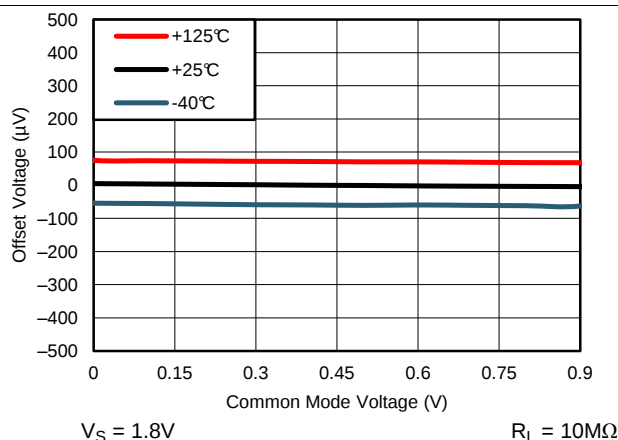


图 11. 典型偏移电压与共模电压间的关系

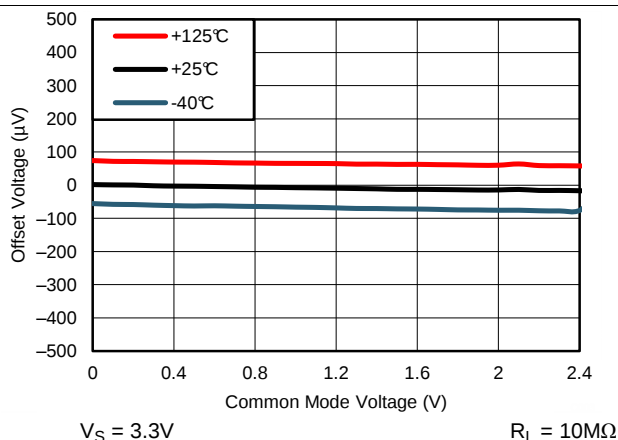


图 12. 典型偏移电压与共模电压间的关系

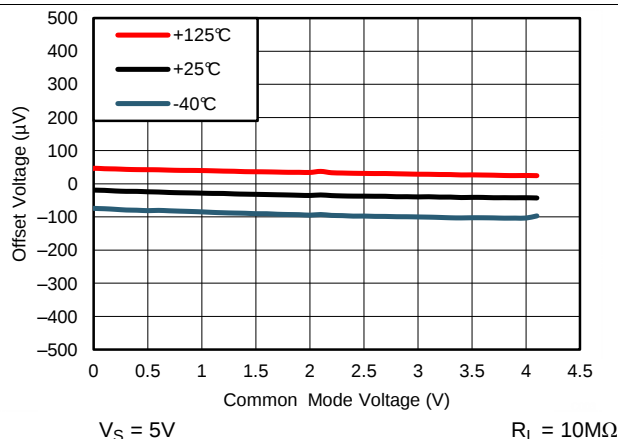


图 13. 典型偏移电压与共模电压间的关系

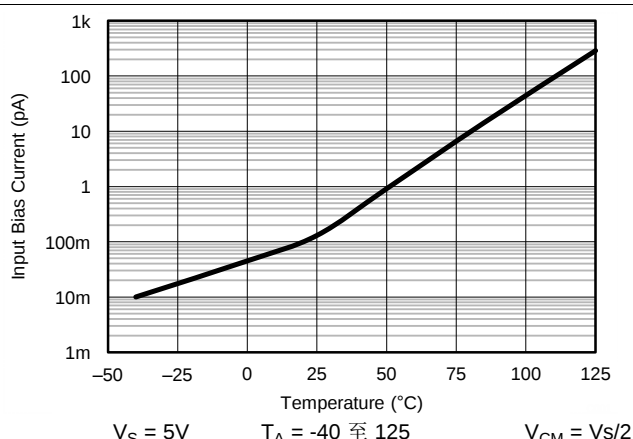


图 14. 输入偏置电流与温度间的关系

典型特性 (接下页)

除非另有说明, 否则 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $R_L = 10\text{M}\Omega$ (连接至 $V_S/2$), $C_L = 20\text{pF}$, $V_{CM} = V_S/2V$ 。

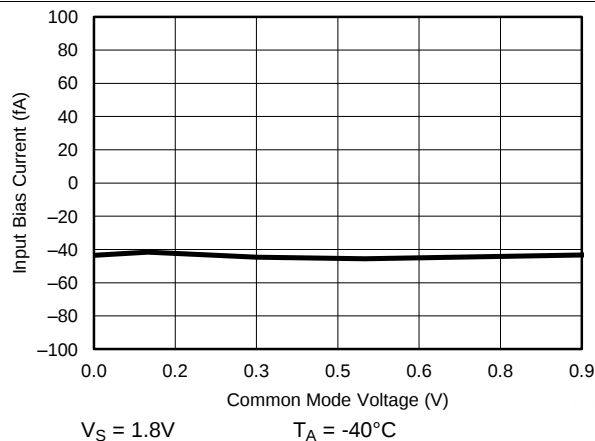


图 15. 输入偏置电流与共模电压间的关系

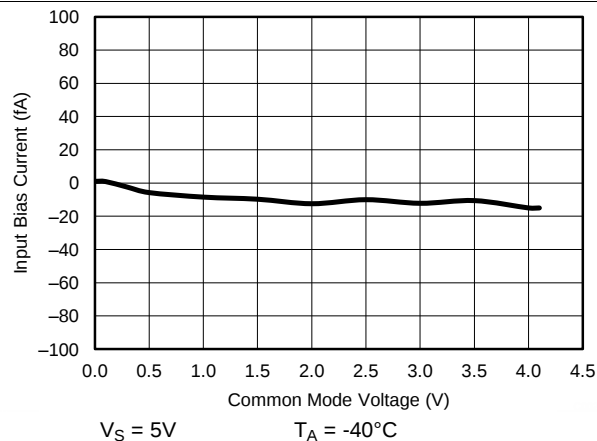


图 16. 输入偏置电流与共模电压间的关系

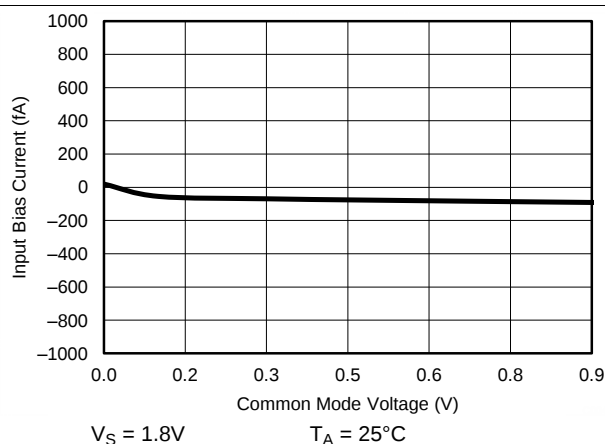


图 17. 输入偏置电流与共模电压间的关系

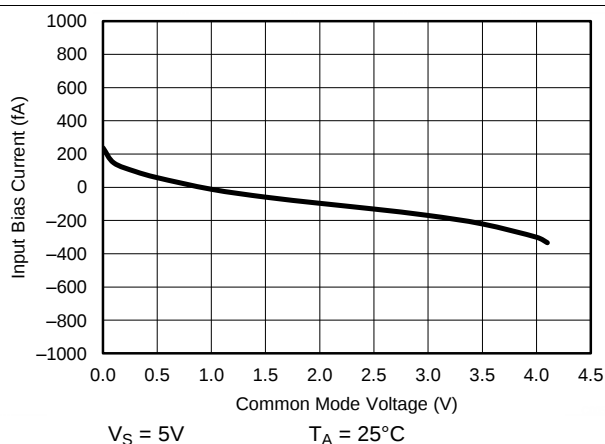


图 18. 输入偏置电流与共模电压间的关系

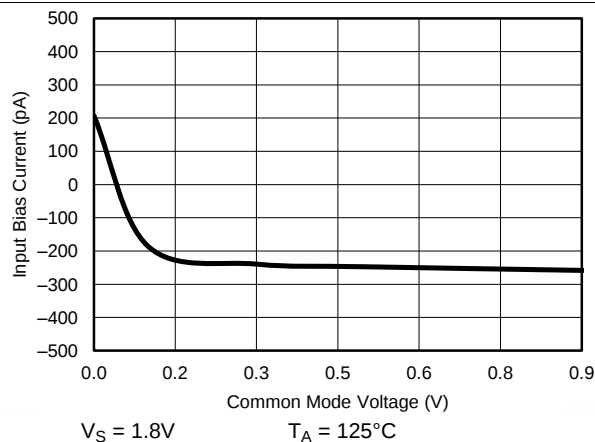


图 19. 输入偏置电流与共模电压间的关系

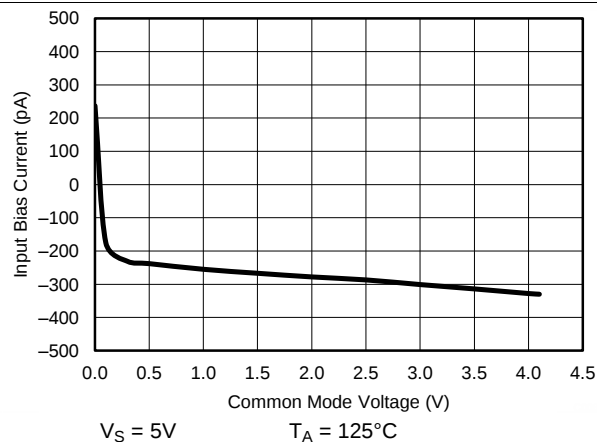


图 20. 输入偏置电流与共模电压间的关系

典型特性 (接下页)

除非另有说明, 否则 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $R_L = 10\text{M}\Omega$ (连接至 $V_S/2$), $C_L = 20\text{pF}$, $V_{CM} = V_S/2$ 。

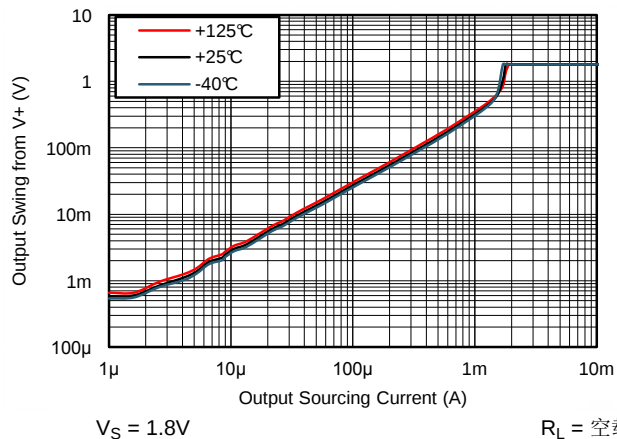


图 21. 输出摆幅与拉电流间的关系, 1.8V

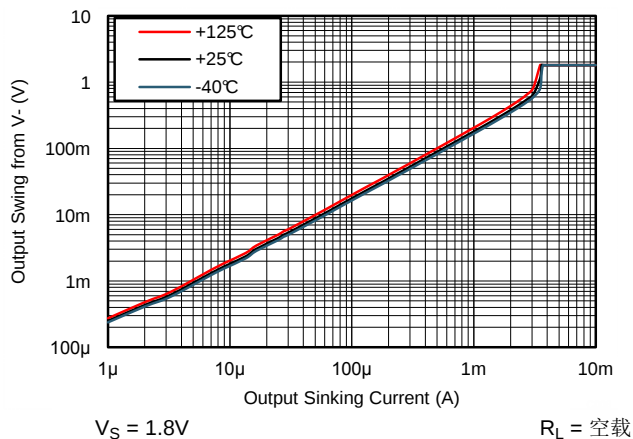


图 22. 输出摆幅与灌电流间的关系, 1.8V

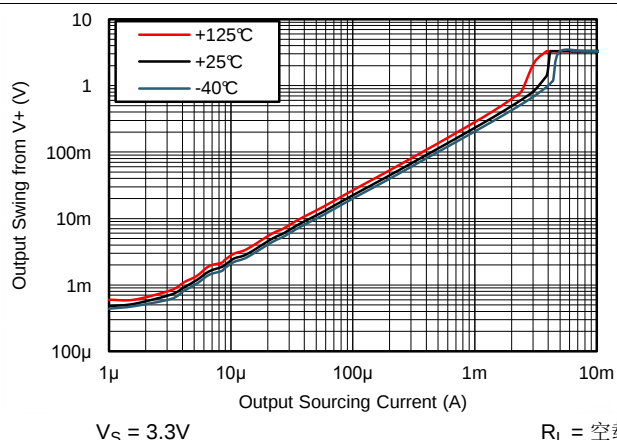


图 23. 输出摆幅与拉电流间的关系, 3.3V

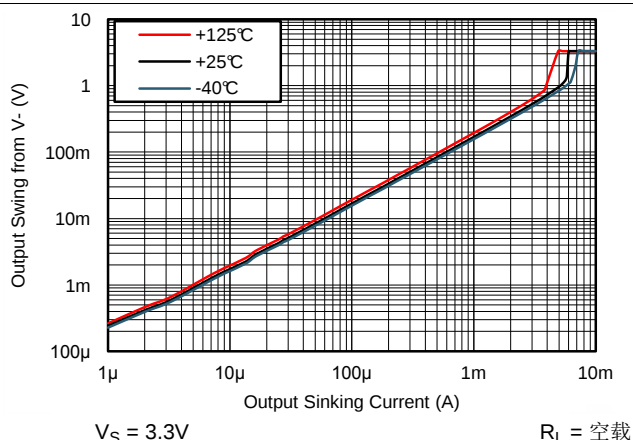


图 24. 输出摆幅与灌电流间的关系, 3.3V

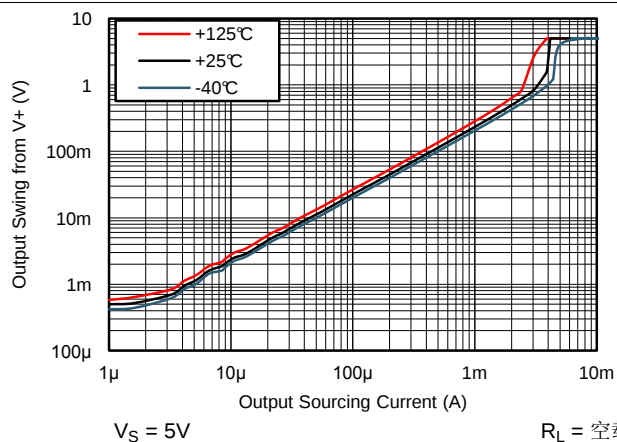


图 25. 输出摆幅与拉电流间的关系, 5V

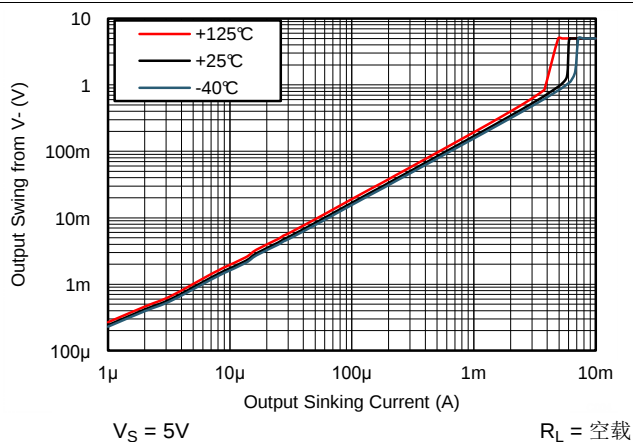
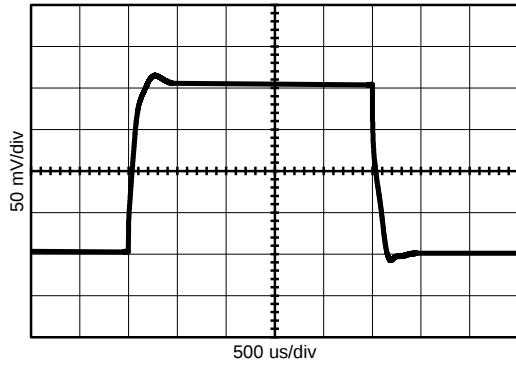


图 26. 输出摆幅与灌电流间的关系, 5V

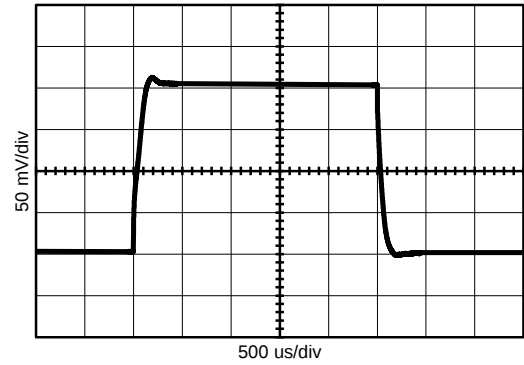
典型特性 (接下页)

除非另有说明, 否则 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $R_L = 10\text{M}\Omega$ (连接至 $V_S/2$), $C_L = 20\text{pF}$, $V_{CM} = V_S/2$ 。



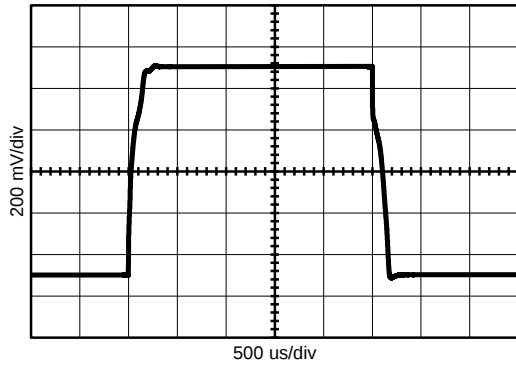
$T_A = 25$ $R_L = 10\text{M}\Omega$ $V_{out} = 200\text{mVpp}$
 $V_S = \pm 0.9\text{V}$ $C_L = 20\text{pF}$ $A_V = +1$

图 27. 小信号脉冲响应, 1.8V



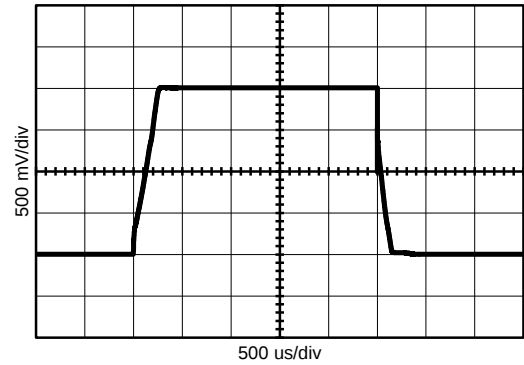
$T_A = 25$ $R_L = 10\text{M}\Omega$ $V_{out} = 200\text{mVpp}$
 $V_S = \pm 2.5\text{V}$ $C_L = 20\text{pF}$ $A_V = +1$

图 28. 小信号脉冲响应, 5V



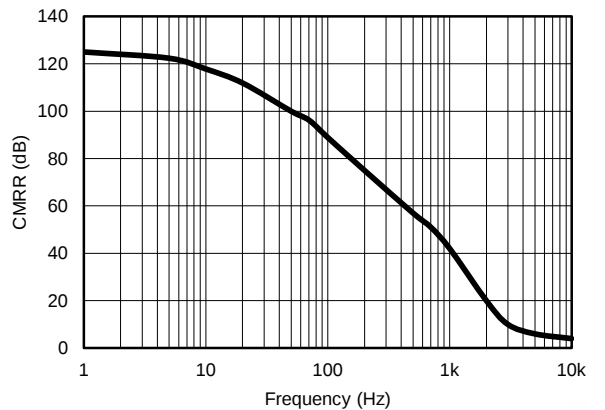
$T_A = 25$ $R_L = 10\text{M}\Omega$ $V_{out} = 1\text{Vpp}$
 $V_S = \pm 0.9\text{V}$ $C_L = 20\text{pF}$ $A_V = +1$

图 29. 大信号脉冲响应, 1.8V



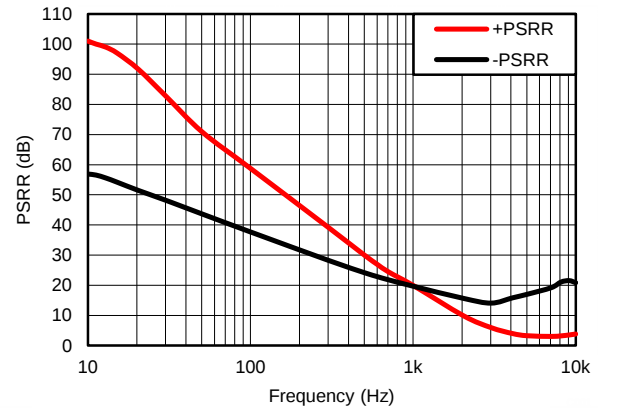
$T_A = 25$ $R_L = 10\text{M}\Omega$ $V_{out} = 2\text{Vpp}$
 $V_S = \pm 2.5\text{V}$ $C_L = 20\text{pF}$ $A_V = +1$

图 30. 大信号脉冲响应, 5V



$T_A = 25$ $R_L = 10\text{M}\Omega$ $\Delta V_{CM} = 0.5\text{Vpp}$
 $V_S = 5\text{V}$ $C_L = 20\text{pF}$
 $V_{CM} = V_S/2$ $A_V = +1$

图 31. CMRR 与频率间的关系

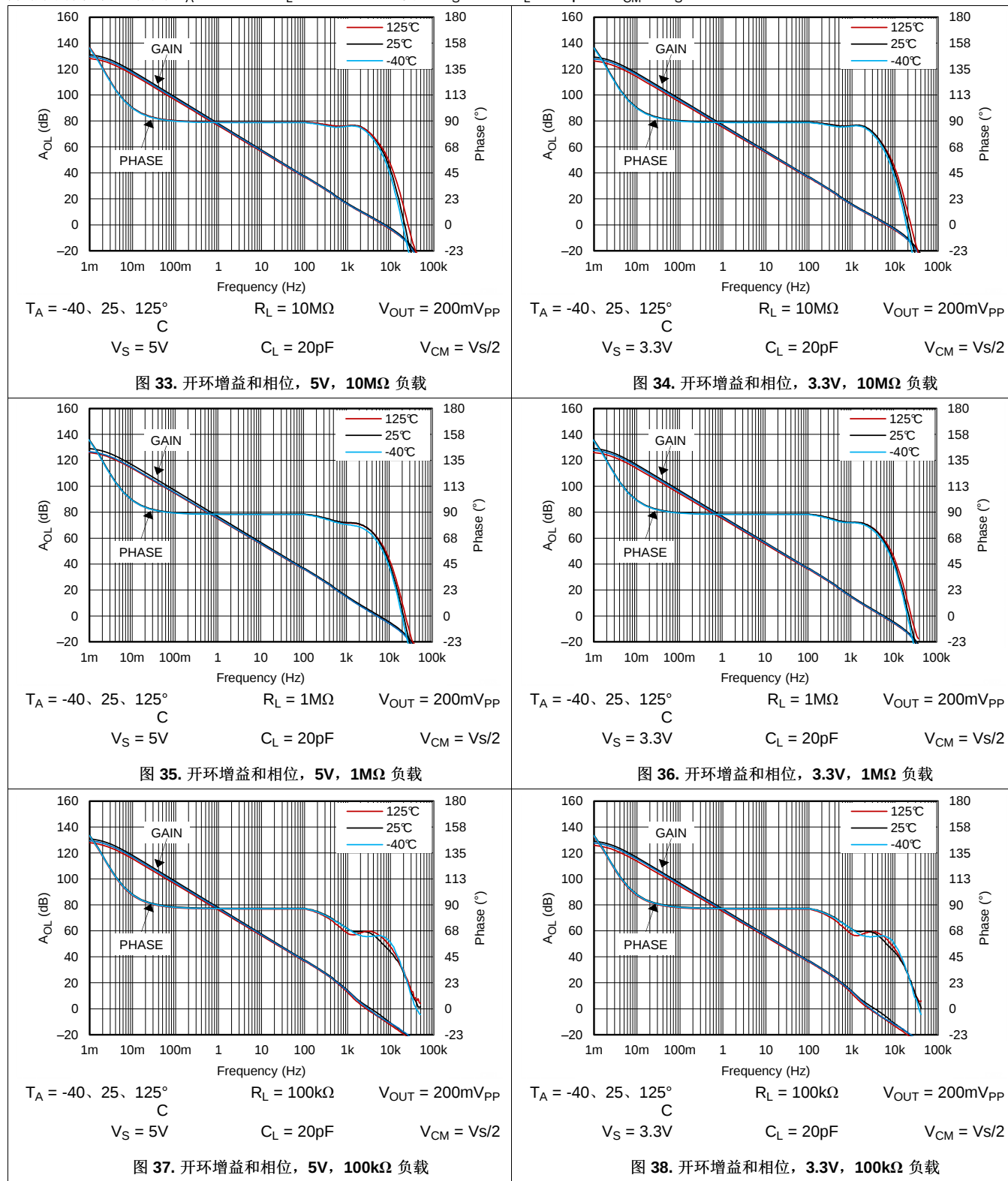


$T_A = 25$ $R_L = 10\text{M}\Omega$ $\Delta V_S = 0.5\text{Vpp}$
 $V_S = 3.3\text{V}$ $C_L = 20\text{pF}$
 $V_{CM} = V_S/2$ $A_V = +1$

图 32. $\pm\text{PSRR}$ 与频率间的关系

典型特性 (接下页)

除非另有说明, 否则 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $R_L = 10\text{M}\Omega$ (连接至 $V_S/2$), $C_L = 20\text{pF}$, $V_{CM} = V_S/2$ 。



典型特性 (接下页)

除非另有说明, 否则 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $R_L = 10\text{M}\Omega$ (连接至 $V_S/2$), $C_L = 20\text{pF}$, $V_{CM} = V_S/2$ 。

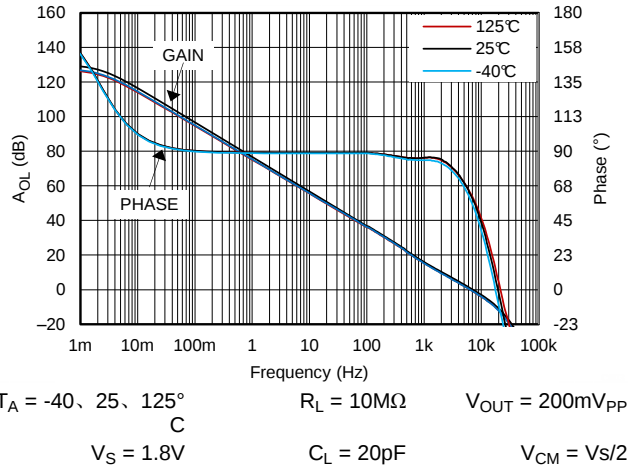


图 39. 开环增益和相位, 1.8V, 10MΩ 负载

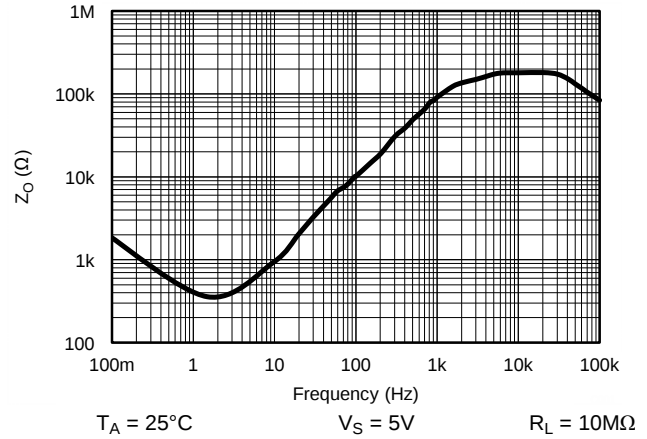


图 40. 开环输出阻抗

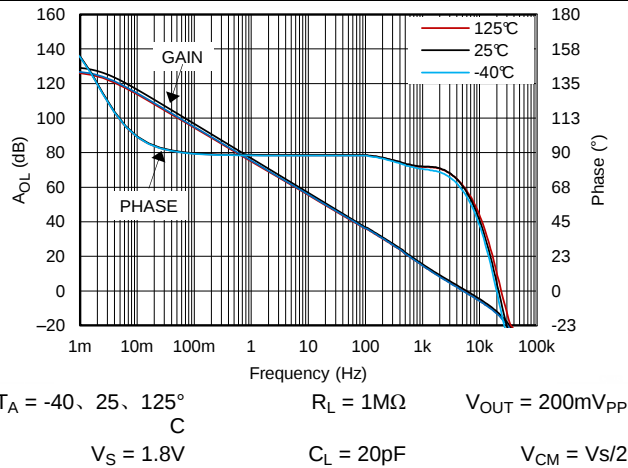


图 41. 开环增益和相位, 1.8V, 1MΩ 负载

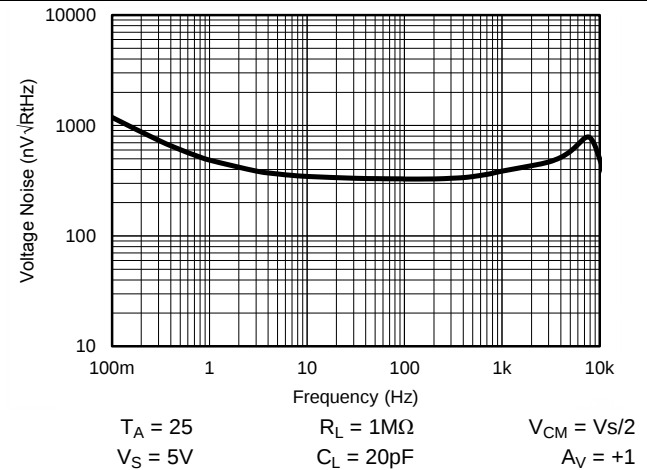


图 42. 输入电压噪声与频率间的关系

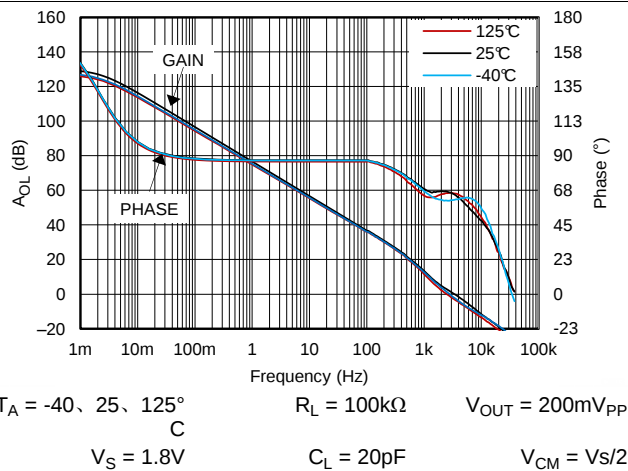


图 43. 开环增益和相位, 1.8V, 100kΩ 负载

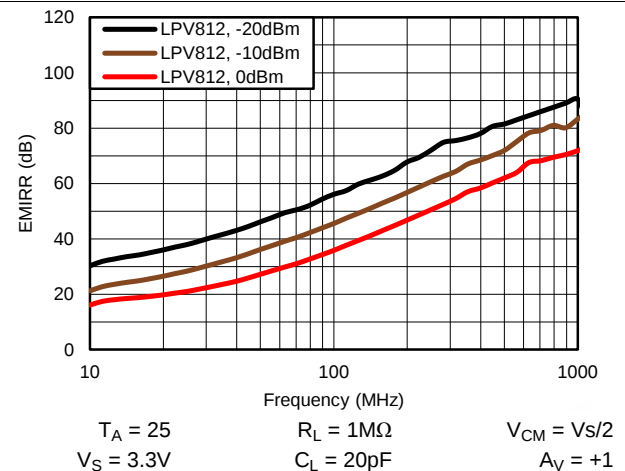


图 44. EMIRR 性能

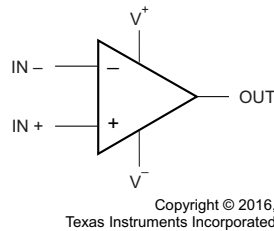
7 详细 说明

7.1 概述

LPV811（单通道）和 LPV812（双通道）系列纳瓦级 CMOS 运算放大器专为长寿命电池供电和能量收集 广泛。它们由单电源供电，工作电压低至 1.6V。输入失调电压修整为低于 300uV，输出为轨至轨，摆幅范围在相对于电源 3.5mV 以内（负载为 100kΩ）。共模范围扩展至负电源，这使得它成为单电源 广泛的理想之选。在内部采用了 EMI 保护，以降低 EMI 的影响。

典型特性 曲线中显示了随工作电压或温度的变化而显著变化的参数。

7.2 功能框图



7.3 特性 说明

放大器的差动输入包含一个同相输入 (+IN) 和一个反相输入 (-IN)。放大器仅放大两个输入之间的电压差，这称为差动输入电压。运算放大器的输出电压 V_{OUT} 由公式 1 给出：

$$V_{OUT} = A_{OL} (IN^+ - IN^-)$$

其中

- A_{OL} 是放大器的开环增益，通常约为 120dB（1,000,000x，或每微伏 1,000,000 伏）。

7.4 器件功能模式

7.4.1 负电源轨感应输入

LPV81x 的输入共模电压范围为 (V-) 至 (V+) – 0.9V。在该范围内，预计能够以 77dB 的最小 CMRR 实现低失调电压。LPV81x 受到“反相”或“反转”保护。

7.4.2 轨至轨输出级

电源为 1.8V 时，LPV81x 输出电压的摆幅为相对于电源轨 3.5mV，这可在输出端提供尽可能大的动态范围。在低电源电压下运行时，这一点尤为重要。

LPV81x 最大输出电压摆幅图定义了特定输出负载下的最大可能摆幅。

7.4.3 针对纳瓦级功率运行的设计优化

在进行超低功耗的设计时，应仔细选择系统反馈组件。为了最大程度地减小静态电流消耗，应选择值较大的反馈电阻器。任何大型电阻器都会在电路中产生杂散电容以及运算放大器的输入电容。这些寄生 RC 组合可能会影响整个系统的稳定性。可能需要使用反馈电容器来确保稳定性并限制过冲或增益峰化。

如有可能，应使用交流耦合和交流反馈来降低通过反馈元件消耗的静态电流。由于大量的电解质可能会产生较大的静态电流（纳安级），因此使用薄膜或陶瓷电容器。

器件功能模式 (接下页)

7.4.4 驱动电容负载

LPV81x 具有 8kHz 典型增益带宽，可在内部得到补偿以实现稳定的单位增益运行。但是，单位增益跟随器是最敏感的电容负载配置。将直接放置在放大器输出端的电容负载与放大器的输出阻抗相结合可产生相位滞后，从而减小放大器的相位裕度。如果相位裕度明显减小，则响应将欠阻尼，这可导致传输中产生峰化，如果峰化过多，运算放大器可能会开始振荡。

为了驱动大型 (>50pF) 电容负载，应该使用隔离电阻器 R_{ISO} ，如图 45 中所示。通过使用此隔离电阻器，电容负载可与放大器的输出相隔离。 R_{ISO} 的值越大，放大器越稳定。如果 R_{ISO} 的值足够大，则反馈环路将保持稳定，不受 C_L 值的影响。但是，较大的 R_{ISO} 值会导致输出摆幅减小和输出电流驱动降低。建议的 R_{ISO} 值为 30-50k Ω 。

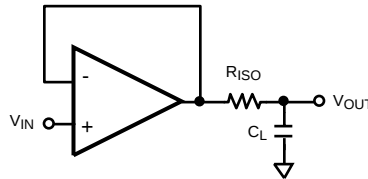


图 45. 电容负载的电阻式隔离

8 应用和实现

注

以下应用部分的信息不属于 TI 组件规范，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定组件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计是否能够实现，以确保系统功能。

8.1 应用信息

LPV81x 是超低功耗运算放大器，能够提供 8kHz 的带宽（典型静态电流仅 425nA）、经修整的输入失调电压和精密漂移规格。这些轨至轨输出放大器专为电池供电的广泛而设计。输入共模电压范围扩展至负电源轨，并且输出摆幅范围处于相对于电源轨的数毫伏以内，从而保持宽动态范围。

8.2 典型应用：三端 CO 气体传感器放大器

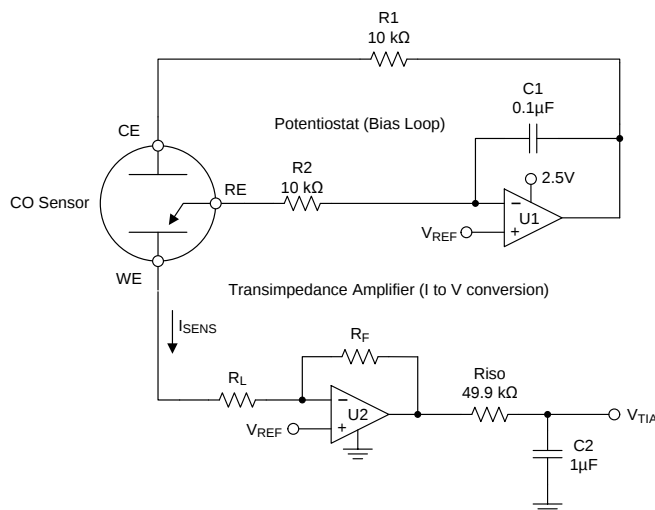


图 46. 三端气体传感器放大器原理图

8.2.1 设计要求

图 46 显示了用于三端非偏置 CO 传感器的简单低功耗稳压器电路，但它还适用于许多其他类型的三端气体传感器或电化学电池。

基本传感器具有三个电极：感应或工作电极（“WE”）、计数器电极（“CE”）和参比电极（“RE”）。电流在 CE 和 WE 之间流动，其大小与检测到的浓度成正比。

RE 监测内部参考点的电势。对于非偏置传感器，必须通过调节 CE 上的偏置将 WE 和 RE 电极保持在相同的电势。通过由 U1 形成的稳压电路，伺服反馈操作会将 RE 引脚保持在由 VREF 设置的电势。

由于传感器的大电容，R1 将保持稳定性。C1 和 R2 形成稳压器积分器并设置反馈时间常数。

U2 形成跨阻放大器（“TIA”），以将产生的传感器电流转换为与之成正比的电压。跨阻增益和最终的灵敏度由 RF 根据公式 2 进行设置。

$$V_{TIA} = (-I * R_F) + V_{REF} \quad (2)$$

RL 是值通常由传感器制造商指定（通常为 10 欧姆）的负载电阻器。WE 上的电势由施加的 VREF 进行设置。Riso 提供电容隔离，并与 C2 相结合形成输出滤波器和 ADC 充电电容器以驱动 ADC。

典型应用：三端 CO 气体传感器放大器 (接下页)

8.2.2 详细设计流程

对于该示例，我们将使用灵敏度为 69nA/ppm 的 CO 传感器。电源电压和最大 ADC 输入电压为 2.5V，最大浓度为 300ppm。

首先，必须确定 V_{REF} 电压。该电压是在最大上余量与分辨率之间进行折衷的结果，也是 CE 端子上最小摆幅的“下余量”的限额，因为随着浓度（传感器电流）增加，CE 通常会相对 RE 电势变为负值。对于该特定的传感器，基准测量发现浓度为 300ppm 时 CE 和 RE 之间的差值为 180mV。

为了允许在 10k 电阻器上出现负 CE 摆幅“下余量”和压降，我们为 V_{REF} 选择了 300mV 的值。

因此，+300mV 将用作最小 V_{ZERO} 以添加一些上余量。

$$V_{ZERO} = V_{REF} = +300\text{mV}$$

其中

- V_{ZERO} 是零浓度电压
 - V_{REF} 是基准电压 (300mV)
- (3)

接下来，我们计算最高预计浓度下的最大传感器电流：

$$I_{SENSMAX} = I_{PERPPM} * \text{ppmMAX} = 69\text{nA} * 300\text{ppm} = 20.7\mu\text{A}$$

其中

- $I_{SENSMAX}$ 是最大预计传感器电流
 - I_{PERPPM} 是制造商指定的每 ppm 传感器电流（以安培为单位）
 - ppmMAX 是所需的最大 ppm 读数
- (4)

现在，求出可用于测量的基准电压之上的可用输出摆幅范围：

$$V_{SWING} = V_{OUTMAX} - V_{ZERO} = 2.5\text{V} - 0.3\text{V} = 2.2\text{V}$$

其中

- V_{SWING} 是预计的输出电压变化
 - V_{OUTMAX} 是最大放大器输出摆幅（通常接近 $V+$ ）
- (5)

现在我们使用最大摆幅和最大电阻器电流计算跨阻电阻器 (R_F) 值：

$$R_F = V_{SWING} / I_{SENSMAX} = 2.2\text{V} / 20.7\mu\text{A} = 106.28\text{k}\Omega \text{（我们将使用 } 110\text{k}\Omega \text{ 作为常用值）}$$
(6)

典型应用：三端 CO 气体传感器放大器 (接下页)

8.2.3 应用曲线

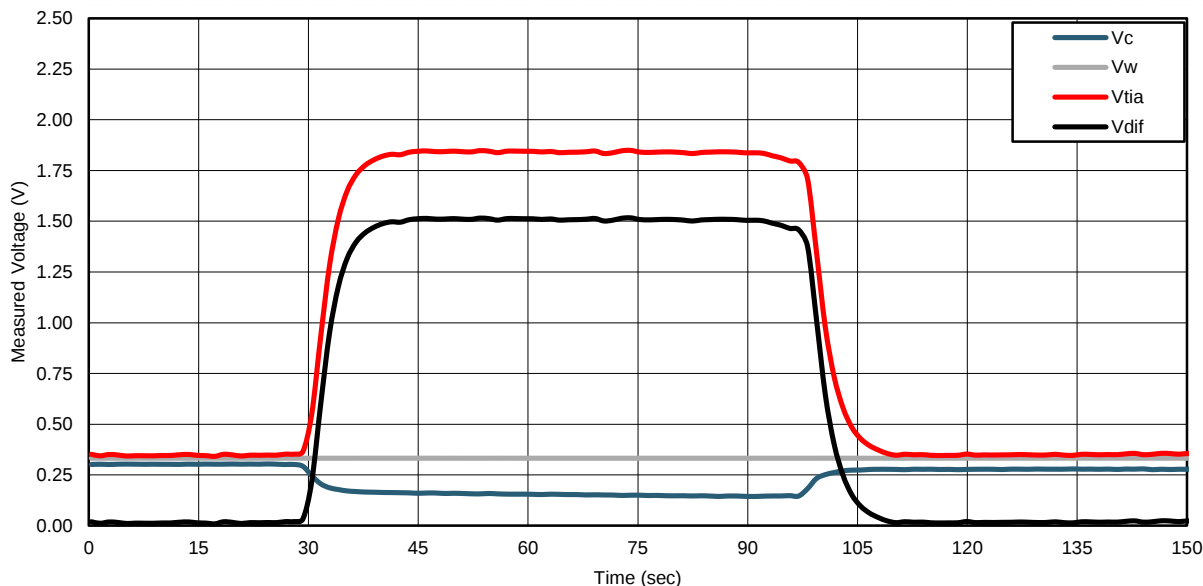


图 47. 接触 200ppm CO 时监测到的电压

图 47 显示了当传感器接触浓度为 200ppm 的一氧化碳气体时产生的电路电压。 V_C 是监测到的 CE 引脚电压，它清楚地显示了随着浓度的增加预计下降至 WE 电压 V_W 以下的 CE 电压。

V_{TIA} 是跨阻放大器 U2 的输出。 V_{DIFF} 是计算出的 V_{REF} 和 V_{TIA} 之间的差值，将用于 ppm 计算。

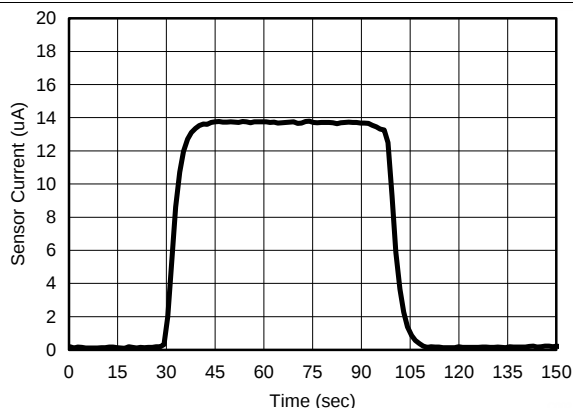


图 48. 计算出的传感器电流

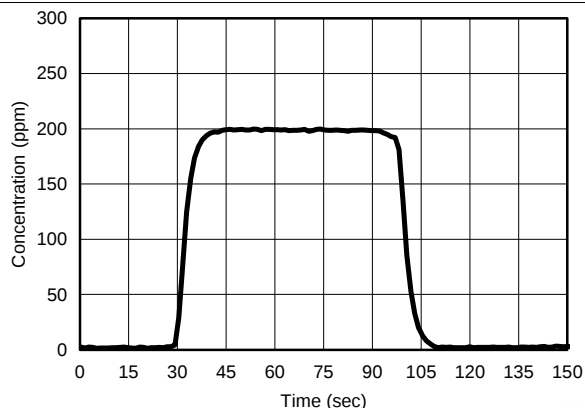


图 49. 计算出的 ppm

图 48 显示了使用公式 7 中的公式计算出的传感器电流：

$$I_{\text{SENSOR}} = V_{\text{DIFF}}/R_F = 1.52\text{V}/110\text{k}\Omega = 13.8\mu\text{A} \quad (7)$$

公式 8 显示了最终的传感器电流到 ppm 的转换。

$$\text{ppm} = I_{\text{SENSOR}}/I_{\text{PERPPM}} = 13.8\mu\text{A}/69\text{nA} = 200 \quad (8)$$

放大器部分的总电源电流小于 700nA，不包括传感器电流。请注意，传感器电流源自放大器输出，该输出又来自放大器电源电压。因此，电源电流预算计算中还必须包含任何持续传感器电流。

8.3 注意事项

应正确旁路掉电源。

在驱动电容负载（尤其是电缆、多路复用器和 ADC 输入）时，应向输出端添加串行电阻。

如果输入电压预计会超过电源，则应添加串行电流限制电阻器和外部肖特基钳位二极管。将电流限制为 1mA 或更小（每伏 1KΩ）。

9 电源建议

LPV81x 的额定工作电压范围是 1.6V 至 5.5V（±0.8V 至 ±2.75V），温度范围是 -40°C 至 125°C。[典型特性](#) 介绍了可能会随工作电压或温度的变化而显著变化的参数。

CAUTION

电源电压超过 6V 可能会对器件造成永久损坏。

为了正确运行，必须适当地对电源进行去耦。为了对电源线进行去耦，建议将 100nF 电容器尽可能靠近运算放大器电源引脚放置。对于单电源，应在 V⁺ 和 V⁻ 电源引线之间放置一个电容器。对于双电源，应在 V⁺ 和接地之间放置一个电容器，并在 V⁻ 和接地之间放置一个电容器。

低带宽纳瓦级功率器件对高频开关电源和其他 1kHz 及频率更高的噪声源并没有良好的高频（大于 1kHz）交流 PSRR 抑制功能，因此，如果预计电源线中会出现 kHz 或频率更高的噪声，则建议使用额外的电源滤波。

10 布局

10.1 布局指南

应使用低 ESR 电容器将 V⁺ 引脚旁路至接地。

放置位置越靠近 V⁺ 和接地越好。

请注意，应最大程度地缩减由 V⁺ 和接地之间的旁路电容器形成的回路区域。

应在器件的引脚上将接地引脚连接至 PCB 接地层。

应将反馈组件尽可能靠近器件放置，以最大程度地减少杂散。

10.2 布局示例

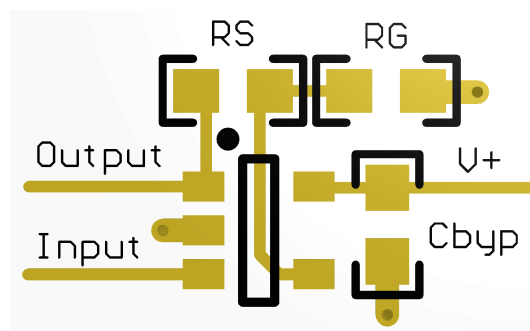


图 50. SOT-23 布局示例（俯视图）

11 器件和文档支持

11.1 器件支持

11.1.1 开发支持

[TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序](#)

[DIP 适配器评估模块](#)

[TI 通用运算放大器评估模块](#)

[TI FilterPro 滤波器设计软件](#)

11.2 Documentation Support

11.2.1 Related Documentation

请参阅如下相关文档：

- [AN-1798 《设计电化学传感器》](#)
- [AN-1803 《互阻抗放大器设计注意事项》](#)
- [AN-1852 《设计 pH 电极》](#)
- [用直观方式补偿互阻抗放大器](#)
- [高速运算放大器跨阻注意事项](#)
- [《FET 互阻抗放大器噪声分析》](#)
- [《电路板布局布线技巧》](#)
- [《运算放大器应用 手册》](#)

11.3 相关链接

下面的表格列出了快速访问链接。类别包括技术文档、支持与社区资源、工具和软件，以及申请样片或购买产品的快速链接。

表 1. 相关链接

器件	产品文件夹	样片与购买	技术文档	工具和软件	支持和社区
LPV811	请单击此处	请单击此处	请单击此处	请单击此处	请单击此处
LPV812	请单击此处	请单击此处	请单击此处	请单击此处	请单击此处

11.4 Receiving Notification of Documentation Updates

To receive notification of documentation updates, navigate to the device product folder on ti.com. In the upper right corner, click on *Alert me* to register and receive a weekly digest of any product information that has changed. 有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

11.5 Community Resources

下列链接提供到 TI 社区资源的连接。链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [《使用条款》](#)。

TI E2E™ 在线社区 [TI 的工程师对工程师 \(E2E\) 社区](#)。此社区的创建目的在于促进工程师之间的协作。在 e2e.ti.com 中，您可以咨询问题、分享知识、拓展思路并与同行工程师一道帮助解决问题。

设计支持 [TI 参考设计支持](#) 可帮助您快速查找有帮助的 E2E 论坛、设计支持工具以及技术支持的联系信息。

11.6 商标

E2E is a trademark of Texas Instruments.

All other trademarks are the property of their respective owners.

11.7 静电放电警告



这些装置包含有限的内置 ESD 保护。存储或装卸时，应将导线一起截短或将装置放置于导电泡棉中，以防止 MOS 门极遭受静电损伤。

11.8 Glossary

[SLYZ022](#) — *TI Glossary*.

This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.

12 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件的最新可用数据。数据如有变更，恕不另行通知和修订此文档。如欲获取此数据表的浏览器版本，请参阅左侧的导航。

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
LPV811DBVR	ACTIVE	SOT-23	DBV	5	3000	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	15TM	Samples
LPV811DBVT	ACTIVE	SOT-23	DBV	5	250	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	15TM	Samples
LPV812DGKR	ACTIVE	VSSOP	DGK	8	2500	RoHS & Green	NIPDAUAG	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LPV 812	Samples
LPV812DGKT	ACTIVE	VSSOP	DGK	8	250	RoHS & Green	NIPDAUAG	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LPV 812	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and

continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LPV811DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LPV811DBVT	SOT-23	DBV	5	250	178.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LPV812DGKR	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.3	3.4	1.4	8.0	12.0	Q1
LPV812DGKT	VSSOP	DGK	8	250	178.0	13.4	5.3	3.4	1.4	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



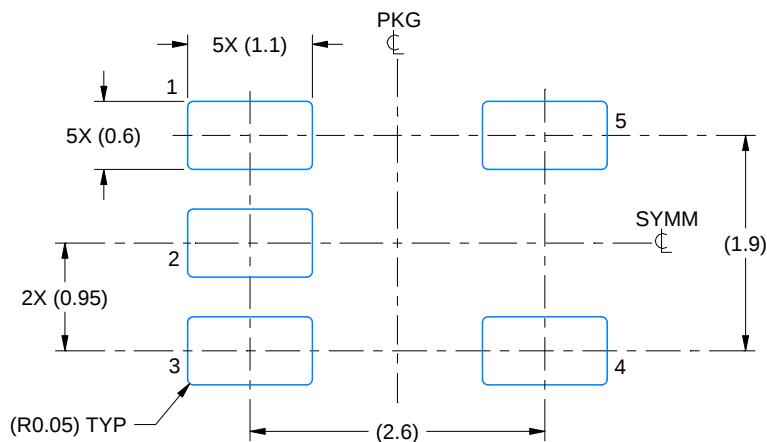
*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LPV811DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
LPV811DBVT	SOT-23	DBV	5	250	210.0	185.0	35.0
LPV812DGKR	VSSOP	DGK	8	2500	364.0	364.0	27.0
LPV812DGKT	VSSOP	DGK	8	250	202.0	201.0	28.0

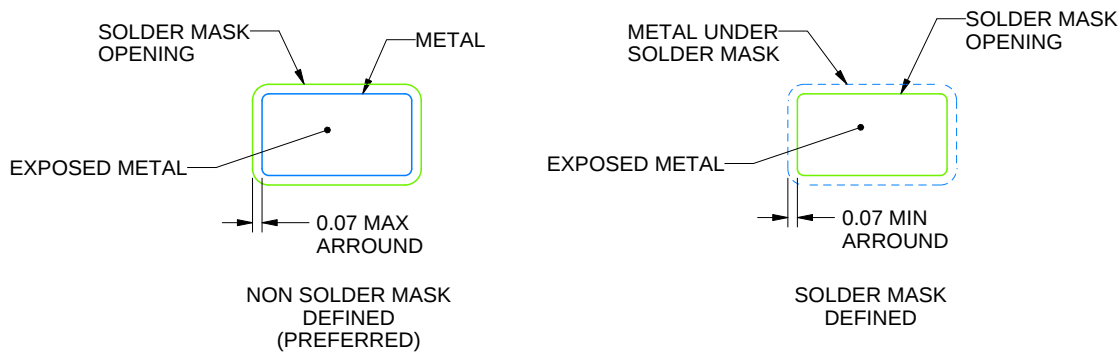
DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4214839/E 09/2019

NOTES: (continued)

5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4214839/E 09/2019

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

DGK (S-PDSO-G8)

PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE



4073329/E 05/06

- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. Body length does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 per end.
 - D. Body width does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.50 per side.
 - E. Falls within JEDEC MO-187 variation AA, except interlead flash.

DGK (S-PDSO-G8)

PLASTIC SMALL OUTLINE PACKAGE



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. Publication IPC-7351 is recommended for alternate designs.
 - D. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and also rounding corners will offer better paste release. Customers should contact their board assembly site for stencil design recommendations. Refer to IPC-7525 for other stencil recommendations.
 - E. Customers should contact their board fabrication site for solder mask tolerances between and around signal pads.

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性 & 可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证其中不含任何瑕疵，且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用 TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品；(2) 设计、验证并测试您的应用；(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更，恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及 TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源，也不提供其它 TI 或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等，TI 对此概不负责，并且您须赔偿由此对 TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受 TI 的销售条款 (<http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html>) 以及 [ti.com.cn](http://www.ti.com.cn) 上或随附 TI 产品提供的其他可适用条款的约束。TI 提供所述资源并不扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼，邮政编码：200122
Copyright © 2020 德州仪器半导体技术（上海）有限公司